

N3000

硅 NPN 外延平面晶体管芯片(4 ")

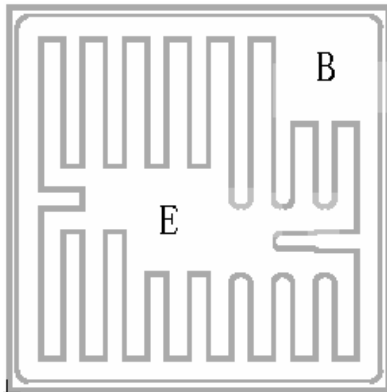
■用途:

- * 电源调整管
- * 音频功率放大器
- * 其他电子电路

■特征:

- *优越的 h_{FE} 线性
- *与 P3000 配对
- *有效图形数 780 只

■芯片示意图



■芯片结构

芯片尺寸	3000 μ m \times 3000 μ m
压焊区尺寸	基区: 770 μ m \times 770 μ m 发射区: 780 μ m \times 780 μ m
芯片厚度	270 \pm 20 μ m
锯片槽宽度	80 μ m
金属层	正面:Al 4 \pm 0.4 μ m 背面:Ag 1.4 \pm 0.2 μ m

■电特性(Ta=25°C)

参数名称	符号	测试条件	最小值					最大值	单位
			A	B	C	D	E		
集电极-基极击穿电压	BV_{CBO}	$I_C=100 \mu$ A, $I_E=0$	80	100	150	180	220		V
集电极-发射极击穿电压	BV_{CEO}	$I_C=30$ mA, $I_B=0$	60	80	120	150	200		V
发射极-基极击穿电压	BV_{EBO}	$I_E=100 \mu$ A, $I_C=0$	7						V
集电极-基极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=0.9BV_{CBO}$, $I_E=0$						1	μ A
发射极-基极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB}=10$ V, $I_C=0$						10	μ A
直流电流增益	h_{FE}	$V_{CE}=5$ V, $I_C=1$ A	65					350	
集电极-发射极饱和电压	$V_{CE(SAT)}$	$I_C=5$ A, $I_B=0.5$ A						2.0	V
特征频率	f_T	$V_{CE}=5$ V, $I_C=1$ A	10						MHz